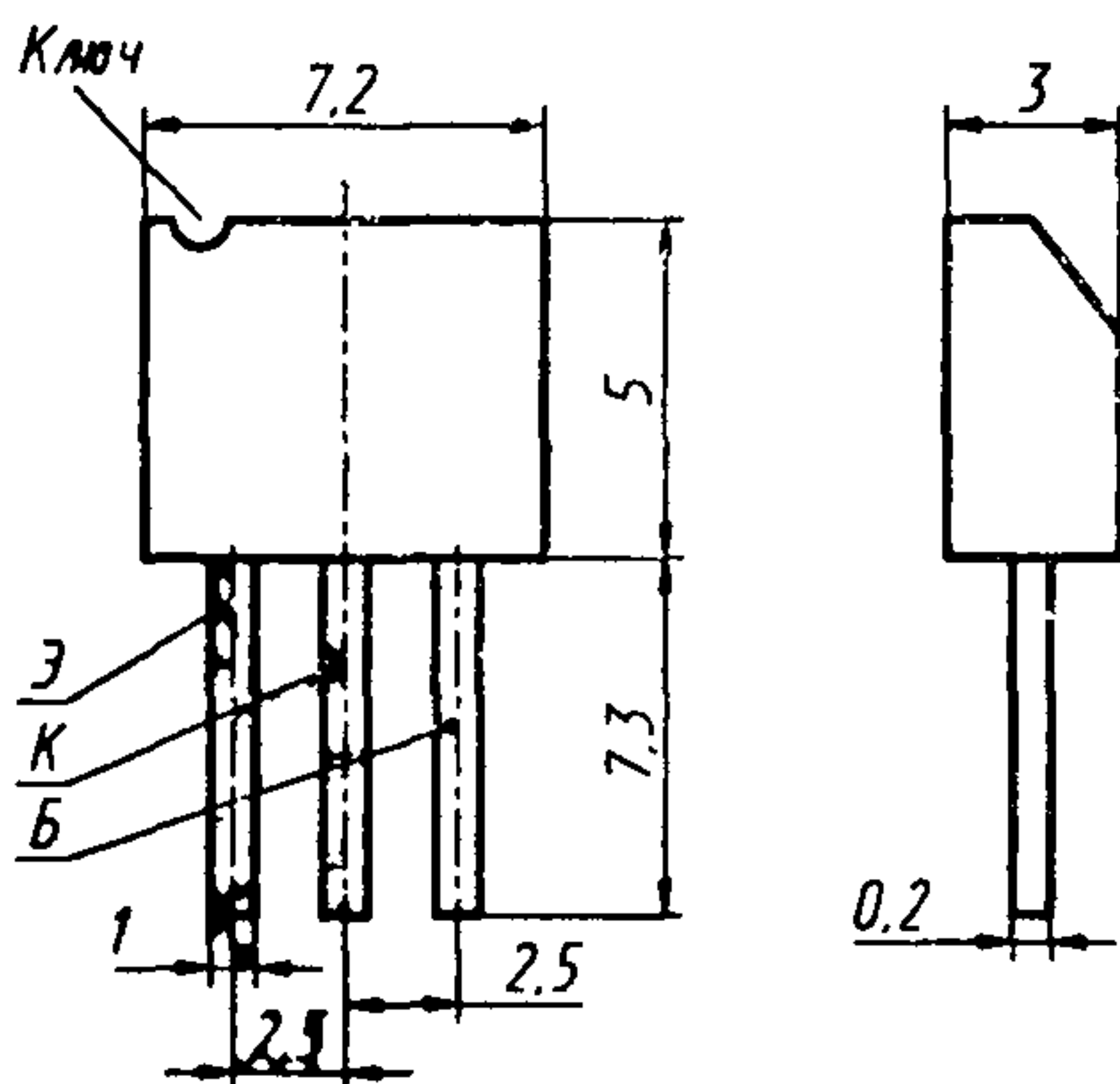


**КТ639А, КТ639Б, КТ639В, КТ639Г,
КТ639Д, КТ639Е, КТ639Ж, КТ639И,
КТ639А1, КТ639Б1, КТ639Г1, КТ639Д1**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, усилителях мощности, видеоусилителях, автомобильных электронных устройствах, импульсных и переключающих устройствах, в оконечных устройствах ЭВМ. Транзисторы КТ639А—КТ639И выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами, транзисторы КТ639(А1, Б1, Г1, Д1) выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами.

КТ639(А1, Б1, Г1, Д1)

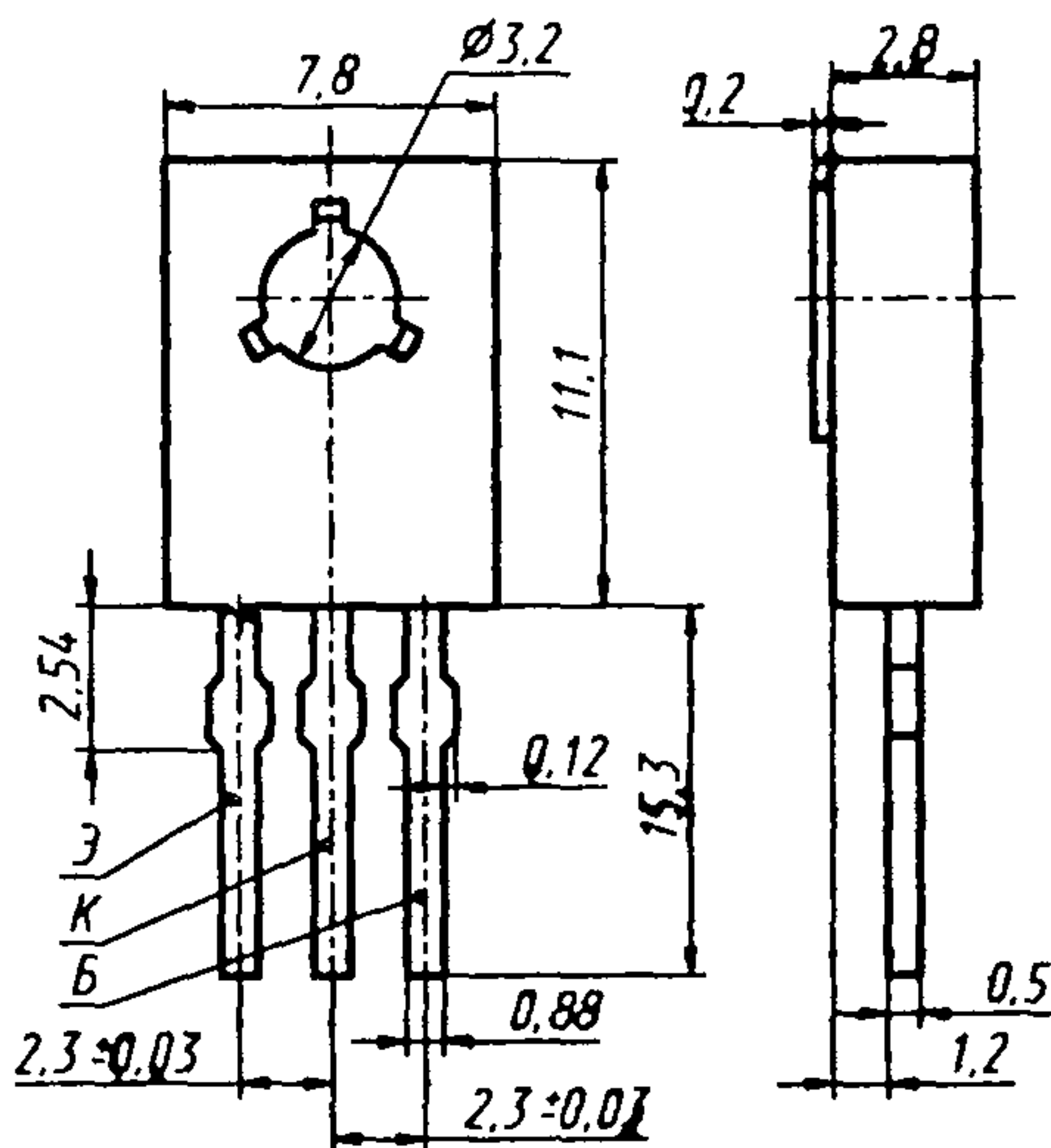


Тип прибора КТ639А—КТ639И указывается на корпусе. Тип прибора КТ639(А1, Б1, Г1, Д1) указывается на этикетке, а также на корпусе в виде буквы соответствующего типонаминала.

Масса транзисторов КТ639А—КТ639И не более 0,7 г, транзисторов КТ639А1—КТ639Д1 не более 0,2 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Рига.

КТ639(А-И)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кз} = 2$ В, $I_k = 150$ мА:

$T = +25$ °С:

КТ639А, КТ639Г, КТ639Е, КТ639А1,
КТ639Г1 40...100

КТ639Б, КТ639Д, КТ639Ж, КТ639Б1,
КТ639Д1 63...160

КТ639В 100...250

КТ639И 180...400

$T = +125$ °С $0,8h_{213 \text{ мин}}$...

$0,3h_{213 \text{ макс}}$

$T = -60$ °С, не менее $0,3h_{213 \text{ мин}}$

Граничная частота коэффициента передачи

тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5$ В, $I_k = 30$ мА 80...200*...
240 МГц

Граничное напряжение при $I_k = 50$ мА,
не менее:

КТ639А, КТ639Б, КТ639В, КТ639А1,
КТ639Б1 45 В

КТ639Г, КТ639Д, КТ639Г1, КТ639Д1 60 В

КТ639Е, КТ639Ж 80 В

КТ639И 30 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 500$ мА, $I_B = 50$ мА	0,15*...0,35*.. 0,5 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 500$ мА, $I_B = 50$ мА	0,92*...0,96*.. 1,25 В
Время рассасывания при $I_K = 500$ мА, $I_B = 50$ мА, типовое значение	200* нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В	15*...20*.. 50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ} = 0,5$ В	90*...120*.. 200 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 30$ В, не более:	
$T = +25$ °С	100 нА
$T = +125$ °С	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В, не более	100 нА

Предельные эксплуатационные данные

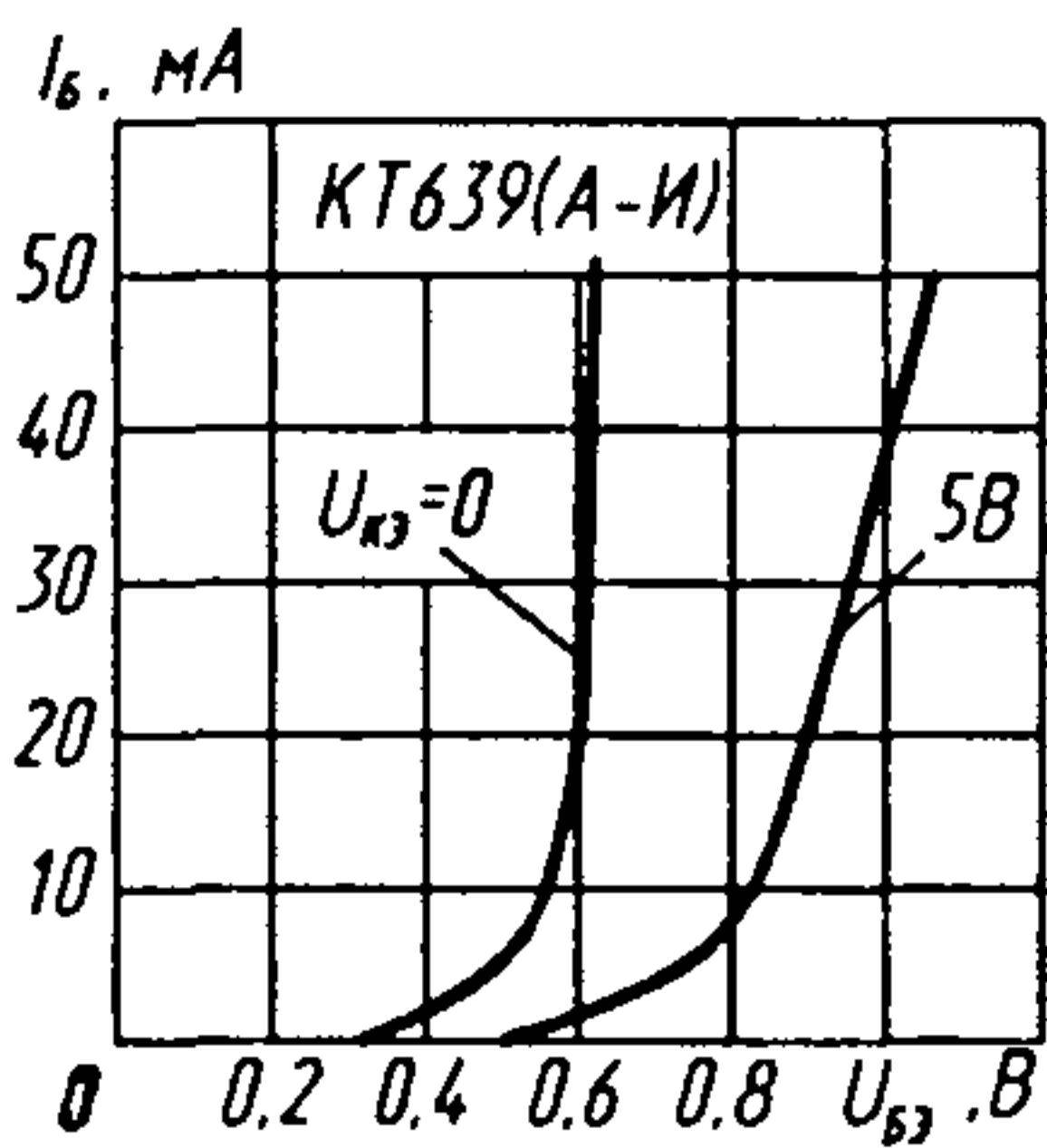
Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ639А, КТ639Б, КТ639В, КТ639А1, КТ639Б1	45 В
КТ639Г, КТ639Д, КТ639Г1, КТ639Д1	60 В
КТ639Е, КТ639Ж	100 В
КТ639И	30 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 1$ кОм:	
КТ639А, КТ639Б, КТ639В, КТ639А1, КТ639Б1	45 В
КТ639Г, КТ639Д, КТ639Г1, КТ639Д1	60 В
КТ639Е, КТ639Ж	100 В
КТ639И	30 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Постоянный ток коллектора	1,5 А
Импульсный ток коллектора при $t_H = 10$ мкс, $Q = 2$	2 А
Постоянный ток базы	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ при $T = -60...+35$ °С:	
КТ639А, КТ639Б, КТ639В, КТ639Г, КТ639Д, КТ639Е, КТ639Ж, КТ639И	1 Вт

¹ При $T > +35$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле

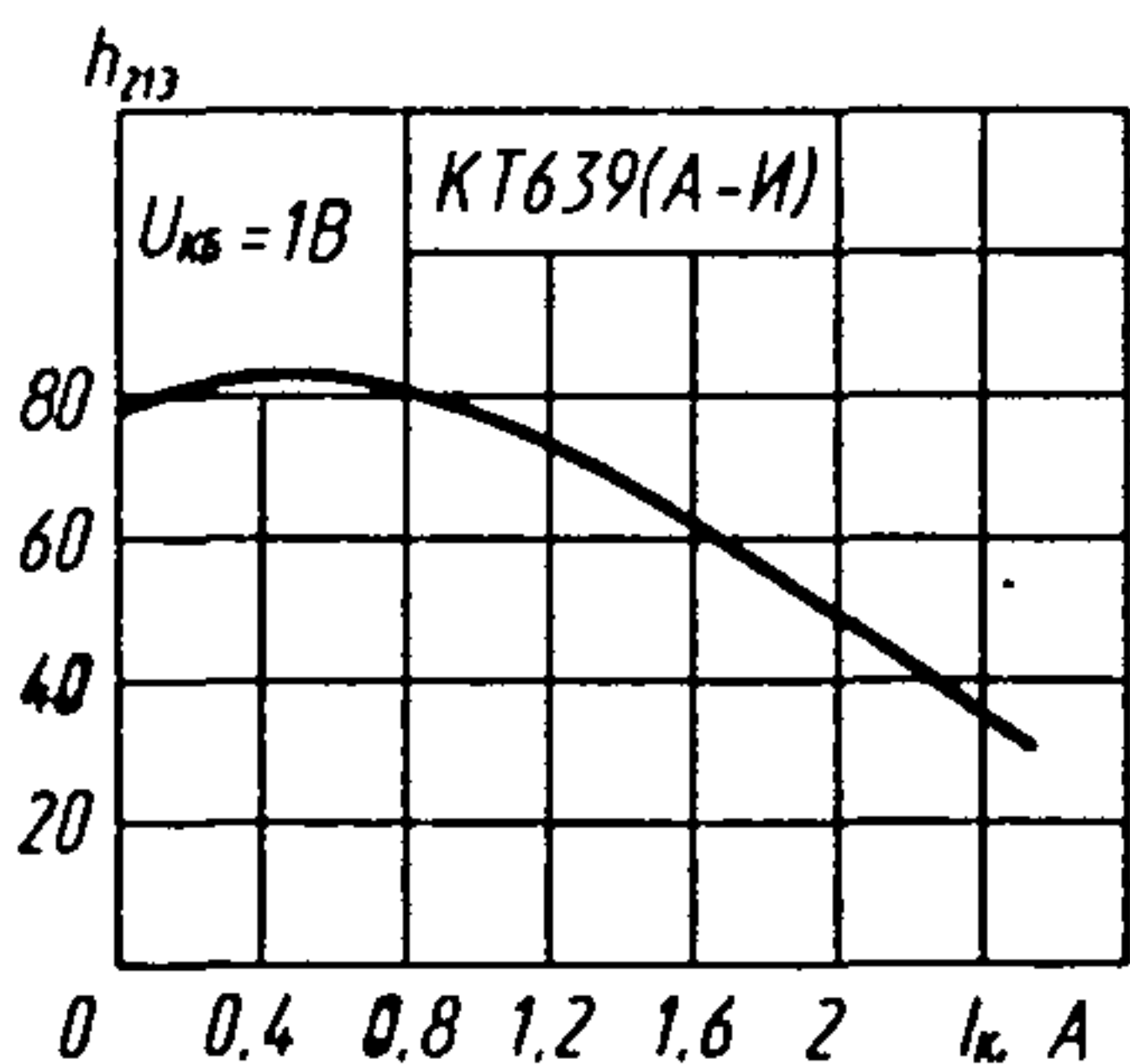
$$P_{K \text{ макс}} = (150 - T_K) / R_{T (п-с)}, \text{ Вт.}$$

КТ639А1, КТ639Б1, КТ639Г1, КТ639Д1	0,5 Вт
Температура р-п перехода	+150 °С
Тепловое сопротивление переход—среда:	
КТ639А, КТ639Б, КТ639В, КТ639Г, КТ639Д, КТ639Е, КТ639Ж, КТ639И	115 °С/Вт
КТ639А1, КТ639Б1, КТ639Г1, КТ639Д1	230 °С/Вт
Температура окружающей среды	−60...+125 °С

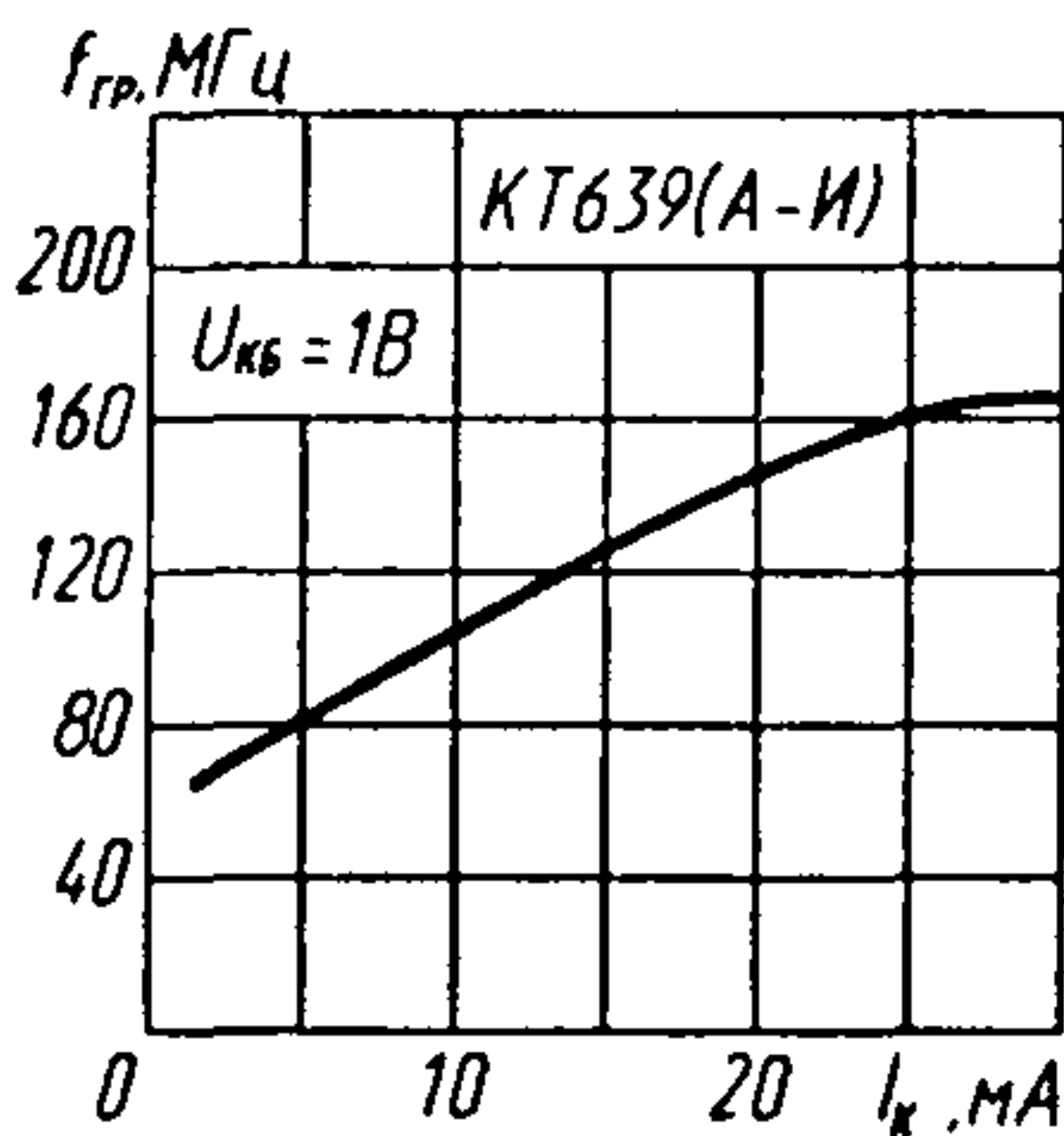
Минимальное расстояние от корпуса до места изгиба вывода 5 мм при радиусе изгиба не менее 1,5 мм. Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса при температуре пайки не выше +250 °С в течение не более 10 с.



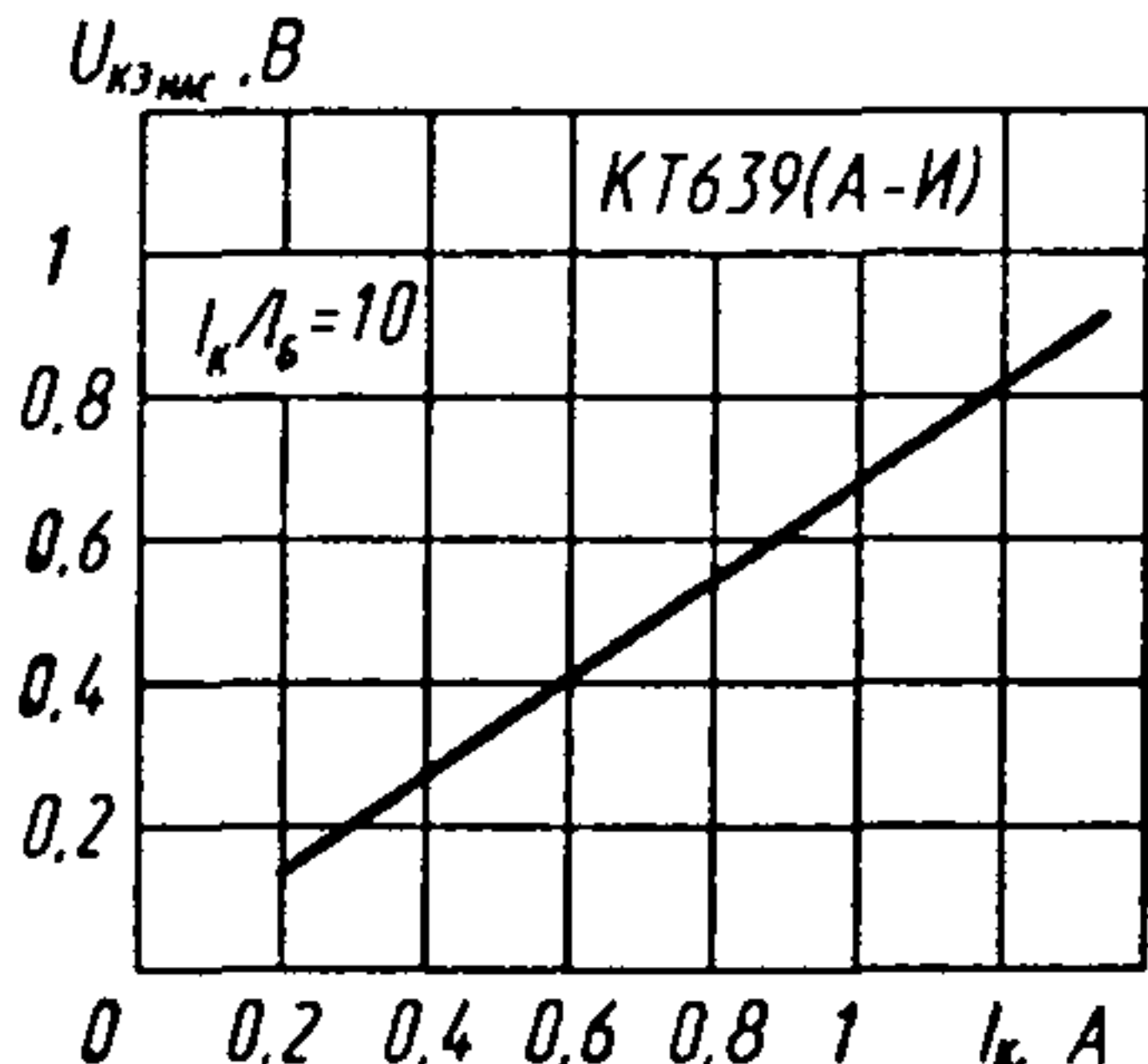
Зависимости тока базы от напряжения база—эмиттер



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость граничной частоты от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора